

Epitaxial Planar PNP Transistor

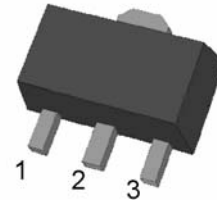
三極管

FHA1001

DESCRIPTION & FEATURES 概述及特點

Low Collector Saturation Voltage
 High Power Dissipation

SOT-89



PIN ASSIGNMENT 引腳說明

PIN NAME 管腳符號	PIN NUMBER 引腳序號	FUNCTION 功能
	SOT-89	
B	1	BASE
C	2	COLLECTOR
E	3	EMITTER

MAXIMUM RATINGS(T_a=25°C) 最大額定值

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V _{CEO}	-20	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V _{CBO}	-35	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V _{EBO}	-8	Vdc
Collector Current(DC)集電極電流-直流	I _C	-3	Adc
Base Current 基級電流	I _B	-0.5	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P _c	500	mW
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T _J T _{stg}	150, -55 ~ 150	°C

DEVICE MARKING 打標

FHA1001=KO(100~200), FHA1001Y=KY(160~320)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(T_A=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I _{CBO}	V _{CB} =-35V, I _E =0	—	—	-100	nA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I _{EBO}	V _{EB} =-8V, I _C =0	—	—	-100	nA
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	V _{(BR)CEO}	I _C =-10mA, I _B =0	-20	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	V _{(BR)EBO}	I _E =-1mA, I _B =0	-8	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	h _{FE1}	V _{CE} =-2.0V, I _C =-0.5A	100	—	320	
	h _{FE2}	V _{CE} =-2.0V, I _C =-3.0A	70	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	V _{CE(sat)}	I _C =-3A, I _B =-75mA	—	—	-0.5	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極壓降	V _{BE}	V _{CE} =-2V, I _C =-3A	—	—	-1.5	V
Transition Frequency 特徵頻率	f _T	V _{CE} =-2V, I _E =0.5A,	—	170	—	MHz
Collect Output Capacitance 輸出電容	C _{Ob}	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHZ	—	62	--	pF